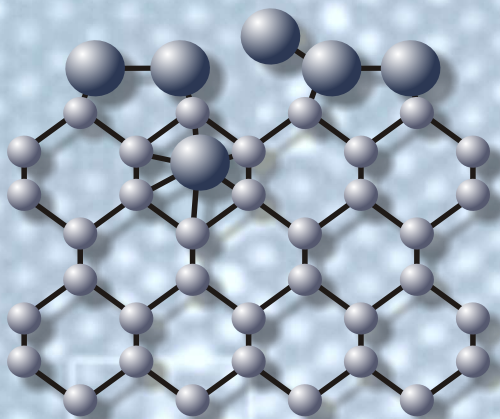


НОВОСИБИРСК
12-15 сентября 2016

**XI Конференция
и X Школа молодых ученых
и специалистов
по актуальным проблемам физики,
материаловедения, технологии
и диагностики кремния,
нанометровых структур
и приборов на его основе**



Кремний-2016

XI Конференция и X Школа молодых ученых и специалистов по актуальным проблемам физики, материаловедения, технологии и диагностики кремния, нанометровых структур и приборов на его основе

КРЕМНИЙ-2016

12-15 сентября 2016, Новосибирск

Конференция "Кремний-2016" является продолжением серии научных конференций посвященных кремнию. Свою историю она ведет с общероссийского совещания по кремнию, проведенного в МИСиС в 1999 году. С 2000 года параллельно с конференцией проводится Школа для молодых ученых и специалистов.

За эти годы мероприятие превратилось в основной форум, где ученые, представляющие академическое сообщество, ВУЗы и промышленность России и стран зарубежья обсуждают актуальные проблемы по всему кругу вопросов, включающему в себя получение металлургического и поликристаллического кремния, рост и материаловедение объемных кристаллов и тонких пленок кремния и родственных материалов, а также физику, технологию и диагностику наноструктур на их основе.

В рамках Школы для молодых ученых и студентов будут прочитаны лекции, призванные ознакомить будущих ученых с наиболее важными и интересными проблемами в области получения кремния и создания современных приборов на его основе.

На конференции будут представлены приглашенные доклады ведущих ученых, работающих в области материаловедения кремния и его применений, а также устные и стендовые доклады.

Конференция будет проходить в курорт-отеле "Сосновка", расположенном в семи километрах от Новосибирского Академгородка, на берегу Бердского залива в живописном сосновом бору.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ:

- ♦ Сибирское отделение РАН;
- ♦ Федеральное агентство научных организаций;
- ♦ Российский фонд фундаментальных исследований;
- ♦ Национальный исследовательский новосибирский государственный университет;
- ♦ Новосибирский государственный технический университет

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

- ♦ Материаловедение кристаллического кремния: получение и очистка металлургического кремния, процессы роста из расплавов, химического осаждения из газовой фазы, аппаратура для роста.
- ♦ Получение кремния солнечного качества и проблемы солнечной энергетики.
- ♦ Атомные процессы на поверхности, границах раздела и в объеме кремния: дефекты, примесные атомы, гетерограницы.
- ♦ Тонкие пленки в кремниевой микроэлектронике: эпитаксиальные слои, кремний-на-изоляторе, напряженные структуры и low и high-k диэлектрик.
- ♦ Физика кремниевых квантово-размерных структур для нано- и оптоэлектроники, фотоники, спинтроники и логических элементов для квантовых вычислений.
- ♦ Нанотехнологии кремниевой электроники, включая, ионную имплантацию, литографию, технологии создания квантовых структур, диагностику.
- ♦ Моделирование процессов роста кремния и структур на его основе, включая разработку алгоритмов и программного обеспечения.
- ♦ Кремниевая электронная компонентная база для наноэлектроники, оптоэлектроники, силовой электроники, светоизлучающих структур, фотоприемников, микромеханики и сенсорики.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ФГБУН Институт физики полупроводников
им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

ФГБУН Институт неорганической химии
им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Сопредседатели:

Латышев А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск
Асеев А.Л. СО РАН, Новосибирск

Зам. председателя

Двуреченский А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск

Ученый секретарь:

Тыщенко И.Е. ИФП СО РАН, Новосибирск

Члены программного комитета:

Аристов В.В. ИПТМ РАН, Черногоровка
Брыкин А.В. ОАО "Росэлектроника", Москва
Волков Н.В. ИФ СО РАН, Красноярск
Вяткин А.Ф. ИПТМ РАН, Черногоровка
Гиваргизов Е.И. ИК РАН, Москва
Грибов Б.Г. "ФГУП "ГНИИ ОСЧМ", Зеленоград
Гуляев Ю.В. ИРЭ РАН, Москва
Дашевский М.Я. НИТУ МИСиС, Москва
Егоров Е.П. ОАО ПХМЗ, Подольск
Зайцев П.А. ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ", Подольск
Земсков В.С. ИМЕТ РАН, Москва
Исюк В.И. АО "НЗПП с ОКБ", Новосибирск
Казанский А.Г. МГУ, Москва
Кведер В.В. ИФТТ РАН, Черногоровка
Красильник З.Ф. ИФМ РАН, Н.Новгород
Красников Г.Я. ОАО "НИИМЭ и Микрон", Москва
Кудрявцева С.В. ОАО НИИ "Изотерм", Брянск
Лукичев В.Ф. ФТИАН, Москва
Неизвестный И.Г. ИФП СО РАН, Новосибирск
Непомнящих А.И. ИГХ СО РАН, Иркутск
Никитов С.А. ИРЭ РАН, Москва
Орликовский А.А. ФТИАН, Москва
Пархоменко Ю.Н. АО ГИРЕДМЕТ, Москва
Попов В.П. ИФП СО РАН, Новосибирск ИАПУ
Саранин А.А. ДВО РАН, Владивосток ИНМЭ РАН,
Сауров А.Н. Москва
Сибельдин Н.Н. ФИАН, Москва
Соболев Н.А. ФТИ им. А.Ф. Иоффе, С.-Петербург
Сорокин Л.М. ФТИ им. А.Ф. Иоффе, С.-Петербург
Стребков Д.С. ВИЭСХ, Москва

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

Регистрационную форму участника конференции следует заполнить на сайте конференции в разделе регистрация.

Тезисы докладов необходимо представить до **15 апреля 2016г.** по электронной почте в адрес Оргкомитета конференции, либо в личном кабинете на сайте конференции.

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ

♦ Объем тезисов не более 1 страницы формата А4, включая встроенные в текст рисунки; поля - верхнее и нижнее 2,5 см, левое и правое 3 см; интервал 1;

♦ редактор Word для Windows;

♦ шрифты Times New Roman: текст - 11 нормальный, прямой; заголовки - 12 жирный; названия организаций, адресные данные, включая электронный адрес, телефон и факс - 11 курсив;

♦ фамилия докладчика подчеркнута - 11 жирный;

♦ ссылки в прямых скобках [], цитируемая литература дается общим списком за текстом.

Шаблон тезисов размещен на сайте конференции.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ

ФГБУН Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН
пр. ак. Лаврентьева 13, 630090, Новосибирск,
Факс: +7(383) 3332771; E-mail: silicon2016@isp.nsc.ru
Web-site: <http://www.isp.nsc.ru/silicon2016>
Тыщенко Ида Евгеньевна, тел.: +7(383) 3335259;
Тычинская Светлана Анатольевна, тел.: +7(383) 3332488
Контактная информация по оплате организационного взноса: Якушева Елена Ивановна, тел.: +7(383)3332981;
e-mail: f-dep4@isp.nsc.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Курорт-отель "Сосновка"
633000, НСО, г.Бердск, Речкуновская зона отдыха.
Web-site: <http://www.sosnovka.biz/>

ВЫСТАВКА

Во время проведения конференции планируется проведение выставки приборов и оборудования, а также новых книг и журналов.

Контактная информация по вопросам участия в выставке: Придачин Николай Борисович, тел.: +7(383) 3307702

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель

Пчеляков О.П. ИФП СО РАН, Новосибирск

Зам. председателя

Каламейцев А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск
Косинова М.Л. ИНХ СО РАН, Новосибирск

Ученый секретарь

Тыщенко И.Е. ИФП СО РАН, Новосибирск

Члены оргкомитета:

Бердников В.С. ИТ СО РАН, Новосибирск
Блошкин А.А. ИФП СО РАН, Новосибирск
Брудный В.Н. ТГУ Томск
Владимиров В.М. КНЦ СО РАН, Красноярск
Войцеховский А.В. ТГУ, Томск
Гаврилов П.М. ФГУП ГХК, Железногорск
Глухов А.В. АО "НЗПП с ОКБ", Новосибирск
Гриценко В.А. ИФП СО РАН, Новосибирск
Ежлов В.С. НИТУ МИСиС, Москва
Жвирблянский В.Ю. АО ГИРЕДМЕТ, Москва
Ивонин И.В. ТГУ, Томск
Исламов Д.Р. ИФП СО РАН, Новосибирск
Кобелева С.П. НИТУ МИСиС, Москва
Колович А.А. ТУ ФАНО, Новосибирск
Косолобов С.С. ИФП СО РАН, Новосибирск
Кучинская П.А. ИФП СО РАН, Новосибирск
Наумова О.В. ИФП СО РАН, Новосибирск
Никифоров А.И. ИФП СО РАН, Новосибирск
Паршин А.С. СибГАУ, Красноярск
Семенова О.И. ИФП СО РАН, Новосибирск
Тимофеев В.А. ИФП СО РАН, Новосибирск
Федик И.И. ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ", Подольск
Федина Л.И. ИФП СО РАН, Новосибирск
Федорук М.П. НГУ, Новосибирск
Филиппов Н.С. ИФП СО РАН, Новосибирск
Харченко В.А. ВЦ ФИЦ ИУ РАН, Москва
Хромов В.П. АО НПП "Восток", Новосибирск
Якимов А.И. ИФП СО РАН, Новосибирск
Якимов Е.Б. ИПТМ РАН, Черногоровка